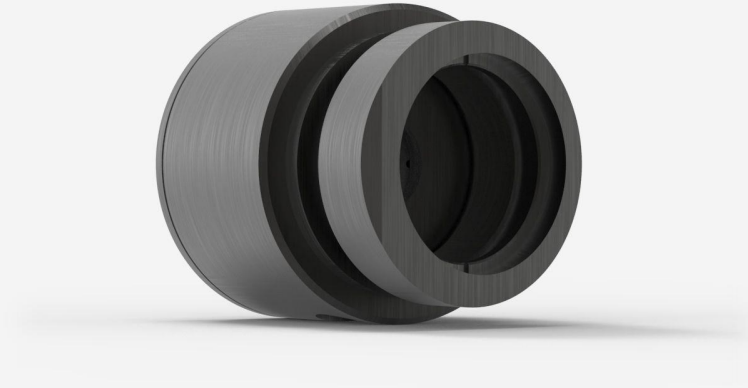


PH100-SiUV-OD.3-D0

光电二极管探测器的激光功率测量高达 16 mW。



产品系列主要特性

大光圈

硅传感器光圈为10 mm直径

3种型号

- 硅 350 - 1080 nm, 高达750 mW
- 紫外硅 210 - 1080 nm, 高达38 mW
- 锗 800 - 1650 nm, 高达500 mW

衰减器选择

高准确度

全新PH100-Si-HA大幅降低校准不确定因素

准确校准

波长选择 1 nm一格

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性支架

[STAND-D-233](#)

规格

测量能力	
最大平均功率 ¹	16 mW
噪声等效功率 ²	20 pW
光谱范围	210 - 1080 nm
典型升起时间	0.2 s
功率校准不确定性 ³	±18 % (210 - 229 nm) ±8.0 % (230 - 254 nm) ±6.5 % (255 - 399 nm) ±5.0 % (400 - 1009 nm) ±7.5 % (1010 - 1080 nm)
峰值灵敏度	850 nm
最小重复率 ⁴	1000 Hz
1. 300 nm, 附有衰减器。查看其他波长的最大功率曲线。 2. 850 nm。标称值。实际值取决于环境电磁干扰和波长。 3. 附有衰减器。查看用户手册, 了解不使用衰减器校准的不确定性。 4. 详细信息请参阅用户手册。	
损坏阈	
最大平均功率密度	100 W/cm²
物理特性	
孔径	10 mm
吸收器	SiUV
尺寸	38.1Ø x 46.3D mm
重量	0.14 kg
距传感器表面距离	13.7 mm
订购信息	
PH100-SiUV-OD.3-D0	202679
PH100-SiUV-OD.3-INT-D0	202792
PH100-SiUV-OD.3-IDR-D0	203238

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表